

Содержание

• Обзоры

Гуткин А.А., Аверкиев Н.С.

Комплексы вакансия галлия — мелкий донор в *n*-GaAs, легированном элементами VI группы Те или S 1021

• Электронные свойства полупроводников

Поклонский Н.А., Вырко С.А., Анисеев И.И., Забродский А.Г.

Максимальная прыжковая электропроводность на постоянном токе по водородоподобным примесям в полупроводниках 1046

Муратов Т.Т.

Эффект компенсации роста времени жизни носителей заряда в полупроводниках в магнитном поле 1055

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Козлов Д.В., Румянцев В.В., Алешкин В.Я., Морозов С.В., Гавриленко В.И.

Влияние оптических фононов на гашение фотолюминесценции вакансий ртути в узкозонных твердых растворах HgCdTe при повышении температуры 1060

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Николаев В.В., Гиршова Е.И., Калитеевский М.А.

Спонтанная эмиссия в утекающие моды нанопроводов . . . 1066

Лабзовская М.Э., Новиков Б.В., Серов А.Ю., Микушев С.В., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Талалаев В.Г.

Оптические свойства нановискеров Cu₂O 1075

Карлина Л.Б., Власов А.С., Смирнова И.П., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю., Токарев М.В., Сошников И.П.

Влияние состава источника на планарный рост нитевидных наноструктур при каталитическом росте в квазизамкнутом объеме 1082

• Физика полупроводниковых приборов

Алексеев Р.П., Куршев П.Л., Цоцорин А.Н.

Влияние многослойного полевого электрода на степень выраженности эффекта квазинасыщения вольт-амперных характеристик мощных сверхвысокочастотных латеральных транзисторов 1088

Eremín V., Fadeeva N., Mitina D., Verbitskaya E.

Analysis of *I*–*V* characteristics of Si diodes irradiated with short-range ions 1093

• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Мынбаева М.Г., Амельчук Д.Г., Смирнов А.Н., Никитина И.П., Лебедев С.П., Давыдов В.Ю., Лебедев А.А.

Создание темплейтов для гомоэпитаксиального роста 3C-SiC методом прямого сращивания пластин карбида кремния различающихся политипов 1094

• Персоналии

Захарий Фишелевич Красильник (к 75-летию со дня рождения) 1099

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Российская академия наук
Ленинский пр., 14, Москва, 199000
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской академии наук
Политехническая ул., 26, Санкт-Петербург, 194021
Телефон: (812)297-2245. Факс: (812)297-1017
post@mail.ioffe.ru <http://www.ioffe.ru>

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
Регистрационный номер ПИ № ФС77-71300 от 17 октября 2017 г.

Издатель: ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Адрес редакции: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
semicond@mail.ioffe.ru
<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>

Зав. редакцией *С. Б. Короткова*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Подписано к печати 31.10.2022. Дата выхода в свет 30.11.2022.
Формат 60×90 1/8.
Усл. печ. л. 10.2. Уч.-изд. л. 9.7.
Тираж 45 экз.
Тип. зак. № 0000. Цена свободная.

Отпечатано с предоставленных готовых файлов
в полиграфическом центре ФГУП Издательство „Известия“
127254, Москва, ул. Добролюбова, 6
телефон: (495)650-3880, <http://izv-udprf.ru>